

AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU DOSYALARI HAZIRLAMA KILAVUZU

2022 yılı Akademik Teşvik Ödeneği başvuru ve değerlendirilmelerinde, 27 Haziran 2018 tarihinde 30461 sayılı ve 17 Ocak 2020 tarihinde 31011 sayılı Resmi Gazetelerde yayınlanan Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği hükümleri esas alınacaktır.

Bu kılavuz, siz değerli öğretim elemanlarımızın akademik teşvik dosyalarının, daha özenli ve hatasız incelenmesi için hazırlanmıştır. Öğretim elemanlarımızın akademik teşvik ödemelerinde problem yaşanmaması için, kılavuzda belirtilen formatlara uyulması önem arz etmektedir.

Dosyalar hazırlanırken format dışı hazırlanan dosyalar, birimlerimizde oluşturulan komisyonlar tarafından ilgililerine tekrar düzenlemeleri için kesinlikle iade edilecek olup, bunun zaman kaybına neden olacağı göz önüne alınmalıdır.

GENEL İLKELER

- Akademik Teşvik Ödeneği başvurusunda yer alan faaliyetlerin 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olması ve başvuru dosyasında belgelendirilmiş olması gerekmektedir.
- Başvuru sahiplerinin sadece kendi temel bilim alanlarında gerçekleştirdikleri faaliyetler, akademik teşvik kapsamında değerlendirilir.
- Akademik teşvik puanının hesaplanmasına esas olmak üzere 2021 takvim yılı içinde yapılmış faaliyetlerin Yükseköğretim Kurulu Bilgi sistemine (YÖKSİS) girilmiş ve sistem çıktısı ve faaliyetlere ilişkin kanıtlayıcı bilgi ve belgelerin yer aldığı dosya ile sunulması gerekmektedir.
- Devlet üniversitelerinden vakıf üniversitelerine görevlendirilen öğretim elemanları, vakıf üniversitelerindeki görevlendirmeleri devam ettiği sürece gerçekleştirdikleri faaliyetlerden dolayı teşvik başvurusunda bulunamazlar.
- Vakıf üniversitelerinden devlet üniversitelerine geçen öğretim elemanları, sadece devlet üniversitelerinde görev yaptıkları sürede gerçekleştirdikleri faaliyetleri için teşvik başvurusunda bulunabilirler.
- Öğretim elemanı başka bir kurumdan gelmiş ise önceki kurumda gerçekleştirdiği ve üniversitemizde gerçekleştirdiği faaliyetleri, YÖKSİS çıktısında her bir faaliyetin hangi kurumda gerçekleştirdiğini ayrı ayrı göstermelidir.
- Puanların ve ödemelerin hesaplanmasında öğretim elemanının teşvik başvurusu yaptığı tarihteki kadro unvanı esas alınır.
- Başvuru dosyasında yer alacak (kanıtlayıcı) belgelerin YÖKSİS çıktısındaki sıralamaya uygun, eksiksiz ve YÖKSİS Eser No ile uyumlu bir şekilde ilişkilendirilmiş olarak hazırlanması gerekmektedir.
- Akademisyenliğe yeni başlayan öğretim elemanlarının kadroya atanma tarihlerinden itibaren yaptıkları yayınlar Akademik Teşvik puanlama sisteminde kullanılabilir.
- Tebliğlerin sunulduğu yurt içinde veya yurt dışındaki etkinliğin uluslararası olarak nitelendirilebilmesi için Türkiye dışında en az beş farklı ülkeden sözlü tebliğ sunan konuşmacının katılım sağlaması ve tebliğlerin yarısından fazlasının Türkiye dışından katılımcılar tarafından sunulması esastır. Ayrıca etkinliğin uluslararası niteliği haiz olup olmadığı hususunda, ödemeye esas teşkil etmek üzere üniversite yönetim kurulu kararının olması gerekir. Bu çerçevede kadronuzun bulunduğu biriminin yönetim kurulunda görüşülmek üzere biriminize kanıtlayıcı belge ile birlikte yazılı olarak başvurunuz. Başvurunuz biriminizin konu ile ilgili yönetim kurulu kararını Üniversite Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere Genel Sekreterliğe gönderilecektir. Bu işlemler Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu toplantısından önce (12 Ocak 2022) tamamlanmalıdır.

FAALİYET TÜRÜ

1-PROJE

Proje; amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak aynı ve/veya nakdi destek tutarları, sonuçta doğacak fikri mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve AR-GE faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetler bütünüdür ifade eder.

2-ARAŞTIRMA

Araştırma; bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte, yükseköğretim kurumu yönetim kurulunun izni ile kurum dışında görevlendirme ile yurtiçinde veya yurtdışında başarı ile yürütülmüş ve sonuç raporu ilgili kurumların yetkili mercilerince başarılı bulunarak sonuçlandırılmış araştırmaları ifade eder.

Araştırmalar ay üzerinden değerlendirilir. Eylem planı, fizibilite raporu ve envanter çalışması ile iki aydan az süren araştırmalar değerlendirmeye alınmaz.

Doktora tezleri, Yüksek lisans tezleri vb. bitirme tezleri Araştırma faaliyeti olarak puanlanmaz.

3-YAYIN

Yayın; dergilerde yayınlanmış derleme, makale veya kısa makale (editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği), kitap veya kitap bölümü, editörlük ve editör kurulu üyeliği ve ses ve/veya görüntü kaydını ifade eder.

Kongre, sempozyum, konferans veya benzeri bilimsel etkinlik kitapçıkları ve içeriğinde yayınlanmış bildiriler, yayın kategorisinde değerlendirmeye alınmaz.

4-TASARIM

Tasarım; bir yapı, ürün veya nesnenin ilk çizim veya taslağını ifade eder.

Tasarım faaliyetinin değerlendirilmesinde sadece bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte, başvuru sahibinin kendi alanı ile ilgili olan ve kamu kurumları veya özel hukuk tüzel kişileriyle yapılan sözleşme uyarınca uygulanmış veya ticarileştirilmiş tasarımlar dikkate alınır.

5-SERGİ

Sergi; sanatsal niteliği haiz sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival veya gösterim etkinliklerini ifade eder.

6-PATENT

Patent; ulusal veya uluslararası kurumlar tarafından tescillenmiş patentleri ifade eder.

Ulusal Patent: Ulusal mevzuat kapsamında başvurusu yapılan ve inceleme raporu sonucunda Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilen patenti,

Uluslararası Patent: Patent İşbirliği Antlaşması kapsamında yapılan ve uluslararası araştırma raporunun yazılı görüş kısmında veya uluslararası ön inceleme raporunda en az bir istemin patentlenebilirlik kriterlerini (yenilik, buluş basamağı, sanayiye uygulanabilirlik) sağladığı ifade edilen uluslararası patent başvurusunu veya Avrupa Patent Sözleşmesi kapsamında başvurusu yapılan ve Avrupa Patent Ofisi tarafından verilen patenti ifade etmektedir.

7-ATIF

Atıf; öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı yayınlarda öğretim elemanının eserlerine yapılan atıfları ifade eder.

Atıfların deęerlendirilmesinde, sadece bu Yönetmelik kapsamında deęerlendirilen yayınlarda veya eserlerde ve bu Yönetmelik kapsamında deęerlendirilen yayınlara veya eserlere yapılan atıflar dikkate alınır, dięerleri kapsam dıřıdır. Sempozyum kitaplarında yer alan bildirilere yapılan atıflar kapsam dıřıdır.

Başvuru sahibinin kendi yayınlarına veya eserlerine yaptığı atıflar kapsam dıřıdır. Başvuru sahibinin, sadece Devlet yükseköğretim kurumlarında üretilen yayınlarına veya eserlerine yapılan atıflar geçerlidir, dięerleri kapsam dıřıdır.

Sadece başvuru yılında alınan atıflar dikkate alınır. Aynı yayın veya esere bir kitabın veya makalenin farklı bölümlerinde/kısımlarında yapılan atıflar yalnızca bir atıf olarak deęerlendirilir. Ancak, bölüm yazarları farklı olan kitaplarda farklı bölümlerde yapılan her bir atıf için ayrı puan deęerlendirmesi yapılır.

Atıf faaliyet türünün puanlanmasında kiři sayısı dikkate alınmaz, her bir arařtırmacı için ayrı puanlama yapılır.

Atıfların Puanlanmasında Atıf yapılan yazarın kaynakça da yer alması yeterlidir.

8-TEBLİę

Tebliğ; hakemli uluslararası bilimsel konferans, sempozyum veya kongrede sözlü olarak sunulan ve yayımlanan bildiriye ifade eder.

Tebliğlerin sunulduęu etkinlięin uluslararası olarak nitelendirilebilmesi için en az beř farklı ülkeden konuşmacının katılım saęlaması esastır. Teblięlerin deęerlendirilmesinde teblięin ilgili etkinlikte sunulmuř ve bunun belgelendirilmiř olması (etkinlik programı ve etkinlięe katılım saęlandığını gösterir belge) esastır. Ayrıca, deęerlendirme için teblięin elektronik veya basılı olarak etkinlik teblię kitapçığında yer alması ve yayınlanmıř tam metninin sunulması gerekir.

Tebliğin alıřmada ismi yer alan en az bir arařtırmacı tarafından sözlü olarak sunulması zorunludur.

9-ÖDÜL

Ödül; öğretim elemanının, kadrosunun bulunduęu kurum tarafından verilenler hari olmak üzere akademik faaliyet alanında gerçekleřtirdięi faaliyetlere karřılık olarak, alanında faaliyet gösteren meslek organizasyonları ile kamu veya özel kuruluşlar tarafından, üyeleri arasında arařtırmacının alanından uzmanların da bulunduęu bir kurulun deęerlendirmesi sonucunda verilen ulusal veya uluslararası düzeyde akademik ve sanatsal ödülleri ifade eder.

1. YÖKSİS'ten Alınacak Başvuru Beyan Formu

<https://yoksis.yok.gov.tr/>

2. Üniversitemiz Sitesinden Alınacak Olan, Akademik Teşvik Başvuru Beyan Formu

<https://akademiktesvik.bandirma.edu.tr/tr/akademiktesvik/Sayfa/Goster/Formlar-2814>

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
.....DEKANLIĞI/MÜDÜRLÜĞÜ
.....BÖLÜMÜ
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BAŞVURU BEYAN FORMU

Başvuru Yapan Öğretim Elemanının

Adı-Soyadı :

Unvanı :

Bölümü :

***Doçentlik Temel Alanı :**

NOT: Formun ekine, YÖKSİS özgeçmiş-puan çıktısını eklemeniz ve beyan ettiğiniz tüm verilerin belgelendirilmesi gerekmektedir. Başvuru esnasında Öğretim Elemanı tarafından doldurularak Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonuna teslim edilir.

Faaliyet Türü	Ham Puan	Net Puan
1) Proje		
2) Araştırma		
3) Yayın		
4) Tasarım		
5) Sergi		
6) Patent		
7) Atıf		
8) Tebliğ		
9) Ödül		
Toplam		

27 Haziran 2018 tarihinde 30461 sayılı ve 17 Ocak 2020 tarihinde 31011 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 01 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 tarihleri aralığını kapsayan faaliyetlerin doğruluğunu ve başvuru konusu akademik performans girdilerimin etik kurallara aykırı hususlar içermediğini, beyan ve taahhüt ediyorum. Aksi durumun tespiti ve onaylanması halinde bahse konu akademik performans girdilerimden dolayı hakkımda ilgili mevzuat hükümleri kapsamında gerekli işlemlerin yapılmasını kabul ediyorum. Akademik teşvik puanımın hesaplanmasına esas olmak üzere 2021 takvim yılı içinde yapmış olduğum faaliyetler Yükseköğretim Kurulu Bilgi sistemine (YÖKSİS) girilmiş ve sistem çıktısı ve faaliyetlere ilişkin kanıtlayıcı bilgi ve belgelerin yer aldığı dosya ekte sunulmuştur. Başvurumun Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde değerlendirmeye alınması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

.. / .. / 2021

Unvan-Adı-Soyadı

3. Klasör



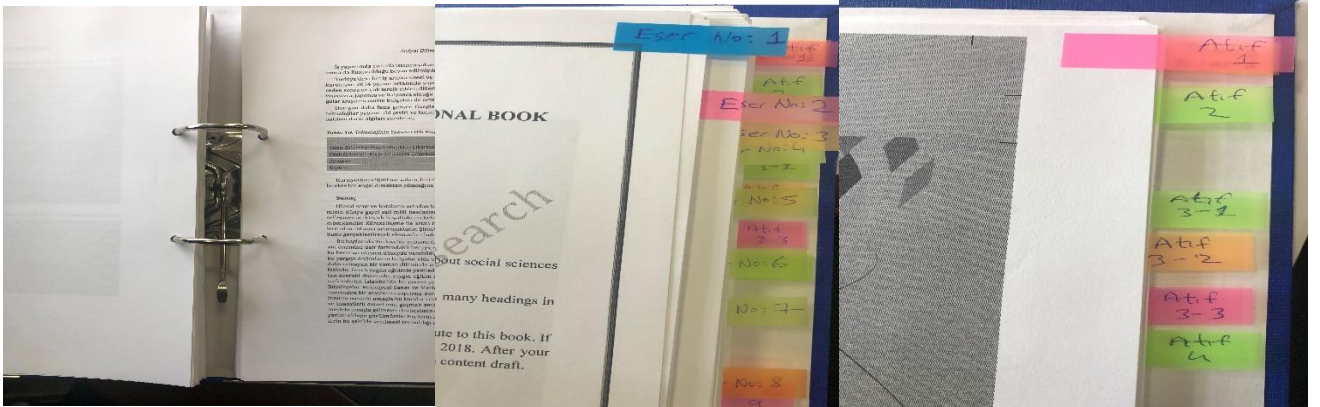
Klasörün yan sırtında başvuru sahibini tanımlayıcı bilgiler yer almalıdır. Örneğin;
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT BÖLÜMÜ Öğr. Üyesi
Prof. Dr.....

4. Eserlerin Yerleştirilmesi

Eserler yerleştirilirken her bir yayın türü (Örn; Makale, Tebliğ) için 2021 yılı Akademik Teşvik Başvuru Formunda yer alan sırayla **poşet dosya kullanmadan** kağıtlar delinerek klasöre yerleştirilecektir.

Yayınlar için: Sıraya göre; Makale, Makalenin İndekslediği Yer, İkinci Makale şeklinde sırasıyla dosyaya yerleştirilecektir. Eser numaraları mutlaka eserlerin üzerinde yer almalıdır. (Bu konuda fotoğraflardaki gibi etiket veya sticker kullanılabilir) İlgili yerler fosforlu kalem ile işaretlenmelidir (Yazar adı, Yayın tarihi, İndeksler vb.)

Atıflar için: Atıf Yapan Eserin İlk Sayfası, Kaynakça ve İndeks Bilgileri yer almalıdır. İlgili yerler fosforlu kalem ile işaretlenmelidir (Kaynakça da atıf yapılan yer, Yayın Yılı ve İndeks)



5. Eser No' un Belirtilmesi

Her bir eser için sırasına göre hazırlanan dosyanın sağ üst köşesine YÖKSİS başvuru dosyasında verilen eser numarası(aşağıda) eklenecektir.

5.1. YÖKSİS'teki Eser No Bölümü:


(3) YAYIN

1.	Eser No	4307898	Tarih	2018	Alan	A1	Puan	7.2
	Unvan, Kurum	DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ, BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ						
	Eser Türü	Makale, Uluslararası, SCI-Expanded,						
	Eser Adı	A new grounded memristor emulator based on MOSFET-C						
	Yazar Bilgisi	Author, Yazar Sayısı=1, YEŞİL ABDULLAH						
2.	Eser No	4243639	Tarih	2018	Alan	A1	Puan	8.64
	Unvan, Kurum	DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ, BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ						
	Eser Türü	Makale, Uluslararası, SCI,						
	Eser Adı	The Fabrication and MOSFET-Only Circuit Implementation of Semiconductor Memristor						
	Yazar Bilgisi	Author, Yazar Sayısı=3, BABACAN YUNUS, YEŞİL ABDULLAH, GÜL FATİH						
3.	Eser No	4243782	Tarih	2018	Alan	A1	Puan	3.6
	Unvan, Kurum	DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ, BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ						
	Eser Türü	Makale, Ulusal, TR DİZİN,						
	Eser Adı	Current and Voltage Mode Quadrature Oscillator Based on Voltage Differencing Buffered Amplifier						
	Yazar Bilgisi	Author, Yazar Sayısı=2, YEŞİL ABDULLAH, KAÇAR FIRAT						

5.2. Eser No'sunun yayına eklenmiş hali:

→ ESER NO: 4307898


Int. J. Electron. Commun. (AEÜ) 91 (2018) 143-149



Contents lists available at ScienceDirect

Int. J. Electron. Commun. (AEÜ)

journal homepage: www.elsevier.com/locate/aeue



Regular paper

A new grounded memristor emulator based on MOSFET-C

Abdullah Yesil

Dept. of Naval Architecture and Marine Engineering, Bandırma Onyedi Eylül University, 10200 Balıkesir, Turkey

ARTICLE INFO

Keywords:
Memristor emulator
Incremental memristor
MOSFET-C
Layout
Experimental results

ABSTRACT

In this paper, memristor emulator circuit consisting of only seven MOS transistors and one grounded capacitor is presented. Memristors exhibit nonlinear voltage-current relationship and many previous emulator circuits have multiplier circuit to provide the nonlinear characteristic of the memristor. But there is no any multiplier circuit block in the proposed circuit so the proposed memristor circuit occupies low chip area. The memristor circuit is laid by using Cadence Environment with TSMC 0.18 μm process parameters and its layout dimensions are only $12 \mu\text{m} \times 38 \mu\text{m}$ excluding the area of the capacitor. The post-layout simulation results for memristor are given to demonstrate the performance of the presented memristor emulator in different operating frequencies, process corner, and radical temperature changes. All post-layout simulations agree well with theoretical analyses. Besides the VLSI implementation of the memristor, the proposed circuit is built on the breadboard using discrete circuit elements.

6. Yazar İsminin Belirtilmesi

Eserlerde ve Kaynakça bölümlerinde geçen ilgili öğretim elemanının adı fosforlu kalemle belirtilecektir.

6.1. Kaynakça gösterimi,

6. References

- [1] Chua, L.O.: 'Memristor: the missing circuit element', *IEEE Trans Circuit Theory*, 1971, CT-18, (5), 507–512. DOI: 10.1109/TCT.1971.1083337
- [2] Strukov, D.B., Snieder, G.S., Stewart, D.R., Williams, R.S.: 'The missing memristor found', *Nature*, 2008, 453, 80–83. DOI:10.1038/nature06932
- [3] Kim, H., Sah, M.P., Yang, C., Cho, S., Chua, L.O.: 'Memristor emulator for memristor circuit applications', *IEEE Trans. Circuits Syst. I Regul. Pap.* 59 (2012) 2422–2431. DOI:10.1109/TCSI.2012.2188957
- [4] Rajeev, K. R., Nishtha, R., Ratnadeep, P., Sajal, K. P., Gaurav, K.: 'Single CCTA based high frequency floating and grounded type of incremental/decremental memristor emulator and its application', *Microelectronics Journal*, 2017, 60, 119–128. DOI:10.1016/j.mejo.2016.12.004
- [5] Yesil, A., Babacan, Y., Kacar, F.: 'A new DDCC based memristor emulator circuit and its applications', *Microelectronics J.*, 2014, 45, 282–287. DOI:10.1016/j.mejo.2014.01.011
- [6] Sanchez-Lopez, C., Mendoza-Lopez, J., Carrasco-Aguilar, M.A., Muniz-Montero, C.: 'A floating analog
- [7] Kumar, R., Niranjan, R., Nidhi, B., Fabian, K.: 'Single DVCCTA based high frequency incremental/decremental memristor emulator and its application', *AEU-Int. J. Electron. Commun.*, 2017, 82, 177–190. DOI: 10.1016/j.aeue.2017.07.039
- [8] Umut, E. A., Shahram, M., Mehmet, S.: 'Memristor emulator circuits using single CBTA', *AEU-Int. J. Electron. Commun.*, 2017, 82, 109–118. DOI: 10.1016/j.aeue.2017.08.008
- [9] Muthuswamy, B., Chua, L.O.: 'Simplest Chaotic Circuit', *Int. J. Bifurc. Chaos.*, 2010, 20, 1567–1580. DOI:10.1142/S0218127410027076
- [10] Chua, L.O., Sbitnev, V., Kim, H.: 'Hodgkin–Huxley Axon Is Made of Memristors', *Int. J. Bifurc. Chaos.*, 2012, 22, 1230011. DOI:10.1142/S021812741230011X
- [11] Jetsdaporn, S., Worapong, T.: 'Compact VDTA-based current-mode electronically tunable universal filters using grounded capacitors', *Microelectronics J.*, 2014, 45, 613–618. DOI: 10.1016/j.mejo.2014.04.008
- [12] Arbel, A.F., Goldminz, L.: 'Output stage for current-mode feedback amplifiers, theory and applications', *Analog Integr. Circ. Sig.*, 1992, 3, 243–255. DOI: 10.1007/BF00276637

6.2. Makale gösterimi,



The Fabrication and MOSFET-Only Circuit Implementation of Semiconductor Memristor

Yunus Babacan, Abdullah Yesil, and Fatih Gul[✉]

Abstract—In this paper, a ZnO-based semiconductor thin film memristor (300 nm in thickness) device is fabricated using metallic top and bottom electrodes by direct-current reactive magnetron sputter. The memristive characteristics of the device were completed by time-dependent current-voltage (I - V - t) measurements, and the typical pinched hysteresis I - V loops of the memristor were observed. This paper is continued with the designing memristor emulator circuit, which has only four MOS transistors. The proposed circuit is suitable both for emulating the fabricated memristor and for using general memristor-based applications. Any circuit blocks such as a multiplier or active element are not used in the circuit to obtain memristive characteristics. All results of the proposed memristor emulator circuit are compatible with general characteristics of the fabricated semiconductor device. The MOSFET-based proposed memristor emulator circuit is laid out in the Analog Design Environment of Cadence Software using 180-nm TSMC CMOS process parameters and its layout area is 366 μm^2 . So as to show its performance, the dependences of the operating frequency and process corner as well as

Memristor characteristics are revealed by most metal-oxide semiconductors, including TiO_2 , TaO_x , ZnO , HfO_2 , VO_2 , and so on [16], [35], [36]. Amongst these oxide-based materials, ZnO has become increasingly popular in recent decades for use in memristor-based devices [37] thanks to its unique optical and electrical properties [38]. The existence of pinched hysteresis loops at the first and third quadrant of the I - V plane is the first fingerprint of semiconductor memristors [39]. These pinched hysteresis loops are definitely shown by our ZnO-based memristor device.

There are many memristor emulators [17]–[30] presented by researchers because of the fact that it was commercially unavailable. But many previous emulators have complex structures or need extra circuit blocks, which cause more power consumption to obtain nonlinear characteristics. These emulators are far from the real memristor circuit element that is why fully MOS transistors based very simple memristor emulator circuit is designed in this paper. Several